



Title	ワイドギャップ半導体4H-SiCにおけるMOS構造用絶縁膜の作製と評価に関する研究
Author(s)	小松, 直佳
Citation	大阪大学, 2011, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/58343
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名	小 松 直 佳
博士の専攻分野の名称	博士(工学)
学 位 記 番 号	第 24591 号
学 位 授 与 年 月 日	平成 23 年 3 月 25 日
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第4条第1項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻	
学 位 論 文 名	ワイドギャップ半導体4H-SiCにおけるMOS構造用絶縁膜の作製と評価に関する研究
論 文 審 査 委 員	(主査) 教授 伊藤 利道 (副査) 教授 森 勇介 教授 谷口 研二 教授 片山 光浩 教授 尾崎 雅則 教授 栖原 敏明 教授 近藤 正彦 教授 森田 清三 教授 八木 哲也

論文内容の要旨

本論文は著者が大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻において行った「ワイドギャップ半導体4H-SiCにおけるMOS構造用絶縁膜の作製と評価に関する研究」の成果をまとめたものである。以下に各章の内容を要約した。

第1章では、本論文作製にあたる研究の背景とその目的を記した。Siに代わるパワーデバイスとして、ワイドギャップ半導体であるSiCを基板としたパワーデバイスの作製が急務の課題であるため、本論文ではSiCパワーMOSFETを念頭に置き、そのゲート絶縁膜をSiパワーMOSFETの場合と同様な熱酸化プロセスによって形成したときの種々の問題を明らかにし、それらの問題を回避できるSiC-MOS構造用絶縁膜探索の重要性を述べ、本論文の目的を明記した。

第2章では、ワイドギャップ半導体SiCを基板としたMOS構造用絶縁膜に求められる条件を述べ、その条件を満たす種々の絶縁体材料の検討を行った結果、AlSiOがSiC-MOS構造用絶縁膜として最も良好な特性を持つ可能性があることを明らかにした。

第3章では、AlSiOの出発材料であるAl_xならびにAlSiOの成膜プロセスとその膜質の評価を行い、AlSiO膜中に含まれるAlやSiの組成比制御や酸素欠損低減のための条件を探索し、光電子分光法に基づいたAl_x膜やSiをドープしたAlSiO膜中の結合状態の評価を行った結果を記述した。

第4章では、AlSiO膜を用いてMOSキャバシタ(Au/AlSiO/Si)を作製しその電気的特性を評価し、Siドーピングによってリーキ電流密度が低減し絶縁性が向上することを見出した。また、その主な原因が絶縁膜中の結合状態に起因していることを明らかにした。さらに、AlSiO薄膜の高温における電流-電圧特性を調べ、絶縁膜中の電気伝導機構に関して、低電界ではオーム性電導を示し、高電界かつ室温領域ではショットキー放出に従うこと、及び、高電界かつ高温下では、ブルーフレンケルの式に従うことを見出した。また、同時に当該絶縁膜の耐熱性的度合いも明らかにした。

第5章では、AlSiO膜中のブルーフレンケル欠陥による耐熱性の劣化を克服する為に、AlSiO膜にNをドープした効果について明らかにした。当該AlSiON膜中の結合状態を解析することにより、NドーピングによりAl-NとSi-N結合が新たに形成され、リーキ電流密度はNをドープしていないAlSiO膜に比べ約1/10に抑制され、特に高温で

り顕著な効果が見出された。このリーキ電流低減機構について、膜中の結合状態とアレニウスの式に基づき、関係する局在準位につちえ検討を加えた。このように、高い耐熱性を持つAlSiON薄膜は、MOSデバイスの高温動作に対しても有効な絶縁膜であることを明らかにした。

第6章は、AlSiON/SiC構造における極薄いAlN層の挿入効果について記載した。SiCと酸化膜との界面にはラフネスが発生しやすく、酸素を含むAlSiON堆積時にも同様な問題が生じたため、SiCとAlSiON膜との挿入するバッファー層として酸素を含まないAl系材料であるAlNの有効性を調べ、界面ラフネスおよびリーキ電流が非常に小さなAlN/SiC構造が作製できることを見出し、AlN極薄膜層挿入のための適正な作製プロセスを明らかにした。

第7章では、本研究にて明らかにしたことの総合を述べた。

論文審査の結果の要旨

本論文は、申請者が電気電子情報工学専攻において行った「ワイドギャップ半導体4H-SiCにおけるMOS構造用絶縁膜の作製と評価に関する研究」の成果をまとめたものであり、各章の内容は以下のように要約される。

第1章では、本論文に関する研究の背景とその目的を明らかにしている。即ち、Siに代わるパワーデバイスとして、作製が急務であるワイドギャップ半導体パワーデバイスの基本的デバイスの一つであるSiCパワーMOSFETの性能を決定する重要な要素であるゲート絶縁膜について、従来のSiに用いられている熱酸化プロセスをSiCに採用した場合に生じる種々の問題点を明らかにし、それらを回避できるSiC-MOS構造用絶縁膜探索の重要性を述べている。

第2章では、ワイドギャップ半導体SiCを基板としたMOS構造用絶縁膜に求められる条件を述べ、その条件を満たす種々の絶縁体材料の検討を行った結果、Al_{1-x}Si_xO_y系(以下AlSiO)膜がSiC-MOS構造用絶縁膜材料として最も良好な特性を持つ可能性があることを明らかにしている。

第3章では、Al_x膜並びにAlSiO膜の作製プロセスとその膜質の評価を行い、AlSiO膜中に含まれるAlやSiの組成比制御や酸素欠損低減のための条件を探索するとともに、Al_x膜やAlSiO膜中の結合状態を光電子分光法により調べることにより、Al_x膜に適切な量のSiを混入したAlSiO膜の優位性を見出している。

第4章では、AlSiO膜を用いてMOSキャバシタ(Au/AlSiO/Si)を作製しその電気的特性を評価することにより、Si混入によってリーキ電流密度が低減し絶縁性が向上することを見出し、その特性改善の要因が絶縁膜中の結合状態に起因していることを明らかにしている。また、パワーデバイス用ゲート絶縁膜として重要となるAlSiO薄膜の高温における電流-電圧特性を調べ、AlSiO絶縁膜中の電気伝導機構に関して、低電界ではオーム性電導を示すこと、高電界かつ室温領域ではショットキー放出に従うこと、及び、高電界かつ高温下では、ブルーフレンケルの式に従うことを見出している。さらに、当該絶縁膜の耐熱性についても知見を得ている。

第5章では、適切にNドープしたAlSiO(以下AlSiON)膜は、AlSiO膜に比べリーキ電流密度が約1/10に低減され、特に高温でより顕著な効果があること、及び、NドープによりAl-NとSi-N結合が形成され、AlSiO膜中で生じていたブルーフレンケル欠陥に起因する耐熱性の劣化を抑制できることを見出している。また、膜中の結合状態と電気的特性を解析することにより、AlSiON絶縁膜中の電気伝導機構に関する局在準位についても知見を得ている。これらの観点から、高い耐熱性を持つ当該AlSiON薄膜はMOSパワーデバイスとして重要な高温動作時にも使用可能な絶縁膜であることを明らかにしている。

第6章は、SiC上に形成したAlSiON薄膜であるAlSiON/SiC構造における極薄いAlN層の挿入効果の有用性について述べている。即ち、SiCと酸化膜との界面にはラフネスが発生しやすく、酸素を含むAlSiON堆積時にも同様な問題が生じたため、SiCとAlSiON膜との挿入するバッファー層として酸素を含まないAl系材料であるAlNの有効性を調べ、界面ラフネスおよびリーキ電流が非常に小さなAlN/SiC構造が作製できることを見出すとともに、AlN極薄膜層挿入のための適正な作製プロセスを明らかにしている。

第7章では、本研究で得られた結論を述べている。

以上のように、本論文は、その開発が急務であるSiCパワーMOSFETにおけるデバイス特性の高性能化の鍵を握るゲート絶縁膜について、(1) 膜組成、電子エネルギー状態、電気的特性や耐熱性の評価、及び、絶縁膜中の電気伝導機

構の解析等に基づき、これまで採用されていない新たな絶縁膜材料として、適切な組成の AlSiON 膜が有力であること、並びに、(2) そのような AlSiON 膜と SiC との界面特性が AlN 極薄膜層の挿入により大幅に向ふることを明らかにしている等、高温下でも使用可能な SiC パワー MOSFET の高性能化に寄与する研究成果が記載されている。

よって、本論文は電気電子情報工学分野の研究進展に貢献しており博士論文として価値あるものと認める。